DERWENT-

1995-167080

ACC-NO:

DERWENT- 199522

WEEK:

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Colour coating ink for cathode ray tube panels contains titanium oxynitride, tin organic acid salt

and/or cobalt organic acid salt, forming less

reflective, antistatic film

PATENT-ASSIGNEE: ASAHI GLASS CO LTD[ASAG]

PRIORITY-DATA: 1993JP-0187278 (June 30, 1993)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE **LANGUAGE PAGES MAIN-IPC**

JP 07089720 A April 4, 1995 N/A 011 C01G 023/00

APPLICATION-DATA:

APPL-APPL-NO APPL-DATE PUB-NO **DESCRIPTOR**

1993JP-September 1, JP N/A

0217209 1993 07089720A

INT-CL C01G023/00, C03C017/22, C09D001/00, C09D005/00,

(IPC): C09D183/04, G02B001/10, H01J029/89

6/26/2006, EAST Version: 2.0.3.0

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 07089720A

BASIC-ABSTRACT:

The coating ink for a CRT contains titanium oxynitride (a), tin organic acid salt (b), and/or cobalt organic acid salt (c). A coloured film, obtd. by heating the coating of the ink or irradiating UV-light on it, is also claimed, whose transparency is decreased over 380-700 nm wavelength. A coloured antistatic film is also claimed, which contains an electroconductive oxide selected from Sn, In, Sb, Zn, Al or Ga oxide, with (a), (b) and/or (c).

ADVANTAGE - A less reflective, larger area antistatic film can be obtd. simply. The ink is stable on storage.

CHOSEN-

Dwg.0/0

DRAWING:

TITLE-

COLOUR COATING INK CATHODE RAY TUBE

TERMS:

PANEL CONTAIN TITANIUM OXYNITRIDE <u>TIN</u>

ORGANIC ACID SALT COBALT ORGANIC ACID

SALT FORMING LESS REFLECT ANTISTATIC FILM

ADDL-

CRT

INDEXING-

TERMS:

DERWENT-CLASS: E19 G02 L01 L03 P81 V05

CPI-CODES: E05-F02; E05-L02B; E31-H05; E31-K; E34-C02; E35-

F; E35-G; E35-H; G02-A04A; G02-A04B; G04-B03;

L01-G04D; L03-C03;

EPI-CODES: V05-D01B; V05-D07B3C; V05-D07C3;

CODES:

CHEMICAL- Chemical Indexing M3 *01* Fragmentation Code A313 A331 A349 A350 A351 A430 A940 C108 C550 C730 C801 C802 C803 C804 C805 C807 M411 M782

M903 M904 Q332 Q454 Q603 R043 Markush

Compounds 199522-D1001-M

Chemical Indexing M3 *02* Fragmentation Code A350 A427 A960 C710 J0 J011 J1 J171 M220 M221 M232 M262 M281 M320 M411 M510 M520 M530 M540 M620 M630 M782 M903 M904 Q332 Q454 Q603 R043 Markush Compounds 199522-D1002-M

Chemical Indexing M3 *03* Fragmentation Code A350 A427 A960 C710 G033 G034 G035 G036 G037 G553 G563 J0 J011 J012 J1 J151 J152 M210 M211 M212 M213 M214 M231 M232 M233 M240 M281 M282 M283 M320 M411 M510 M520 M530 M541 M630 M782 M903 M904 Q332 Q454 Q603 R043 Specfic Compounds 07251M 15313M

Chemical Indexing M3 *04* Fragmentation Code A422 A940 C107 C108 C520 C730 C801 C802 C803 C804 C807 M411 M782 M903 M904 Q332 Q454 Q603 R043 Markush Compounds 199522-D1003-M

: 1515U : 1520U : 1527U : 1531U UNLINKED-DERWENT-; 1537U ; 1544U **REGISTRY-NUMBERS:**

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1995-077300

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1995-131343

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-89720

(43)公開日 平成7年(1995)4月4日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所			
C01G 23/00	Z						
C 0 3 C 17/22	Z						
C 0 9 D 1/00	PCJ						
5/00	PPM						
		7724-2K	G02B	1/ 10 Z			
		審査請求	未請求 請求項	間の数15 OL (全 11 頁) 最終頁に続く			
(21)出顧番号	特顧平5-217209		(71)出顧人	000000044			
				旭硝子株式会社			
(22)出顧日	平成5年(1993)9月	11日		東京都千代田区丸の内2丁目1番2号			
			(72)発明者	平塚 和也			
(31)優先権主張番号	特願平5-187278			神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地			
(32)優先日	平 5 (1993) 6 月30日	Ī		旭硝子株式会社中央研究所内			
(33)優先権主張国	日本(JP)		(72)発明者	真田 恭宏			
				神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地			
				旭硝子株式会社中央研究所内			
			(72)発明者	阿部 啓介			
				神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地			
			}	旭硝子株式会社中央研究所内			
			(74)代理人	弁理士 泉名 謙治			
				最終頁に続く			

(54) 【発明の名称】 着色膜形成用塗布液、着色膜、着色帯電防止膜、および着色低反射帯電防止膜

(57)【要約】

【構成】酸窒化チタンと、Sn有機酸塩および/または Co有機酸塩とを含む着色膜形成用塗布液、および該塗 布液を塗布し、加熱および/または紫外線を照射して得 られる着色膜。

【効果】低温熱処理が可能であり、全可視光領域において均一な吸収を有するため低反射特性がすぐれている。 また、窒素を含有してなる酸化チタン自体は導電性を有しているため帯電防止能を発現することができる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】酸窒化チタンと、Sn有機酸塩および/またはCo有機酸塩とを含む着色膜形成用塗布液。

【請求項3】Sn、In、Sb、Zn、AlおよびGa のうち少なくとも 1種からなる導電性酸化物を含むことを特徴とする請求項1または2記載の着色膜形成用塗布液。

【請求項4】前記Sn有機酸塩が、ナフテン酸第1スズ および2-エチルヘキサン酸スズの少なくとも1種であ ることを特徴とする請求項1~3いずれか1項記載の着 20 色膜形成用塗布液。

【請求項5】前記Co有機酸塩が、ナフテン酸第1コバルトおよび2-エチルヘキサン酸コバルトの少なくとも1種であることを特徴とする請求項1または3記載の着色膜形成用塗布液。

【請求項6】前記酸窒化チタンが、Nを $0.1\sim30w$ t%含有する TiO_x ($1.0\leq x<2.0$)であることを特徴とする請求項 $1\sim5$ いずれか1項記載の着色膜形成用塗布液。

【請求項7】請求項1~6いずれか1項記載の塗布液を 30 塗布した後、加熱および/または紫外線を照射すること により得られたことを特徴とする380 nmから700 nmの波長領域において透過率が低下された着色膜。

【請求項8】基体表面に、酸窒化チタンを含み、さらに Sn有機酸塩およびCo有機酸塩のうち少なくとも1種 を含み、さらにSn、In、Sb、Zn、AlおよびG aのうち少なくとも1種からなる導電性酸化物を含む溶 液を塗布した後、加熱および/または紫外線を照射する ことにより得られたことを特徴とする380nmから7 00nmの波長領域において透過率が低下され、かつ帯 40 電防止能を有する着色帯電防止膜。

【請求項9】基体表面に、酸窒化チタンを含み、さらに Sn有機酸塩およびCo有機酸塩のうち少なくとも1種を含み、さらにSn、In、Sb、Zn、AlおよびG aのうち少なくとも1種からなる導電性酸化物を含む溶液を塗布した後、加熱および/または紫外線を照射することに被膜を形成し、さらにこの上に当該被膜よりも低屈折率を有する膜を形成したことを特徴とする380nmから700nmの波長領域において透過率が低下され、かつ共興防止性などが低原射性を有する差色低原射 带電防止膜。

【請求項10】基体上に形成された多層膜からなり、そのうち少なくとも1層が酸窒化チタンを含み、さらにSn有機酸塩およびCo有機酸塩のうち少なくとも1種を含み、さらにSn、In、Sb、Zn、Al、Gaのうち少なくとも1種の導電性酸化物を含む溶液を塗布したことにより得られる被膜であることを特徴とする着色低反射帯電防止膜。

2

【請求項11】前記Sn有機酸塩が、ナフテン酸第1ス 10 ズおよび2-エチルヘキサン酸スズの少なくとも1種であることを特徴とする請求項8~10いずれか1項記載の着色膜、着色帯電防止膜および着色低反射帯電防止

【請求項12】前記Co有機酸塩が、ナフテン酸第1コバルトおよび2-エチルヘキサン酸コバルトの少なくとも1種であることを特徴とする請求項8~10いずれか1項記載の着色膜、着色帯電防止膜および着色低反射帯電防止膜。

【請求項13】前記酸窒化チタンが、Nを $0.1\sim30$ wt%含有する TiO_x ($1.0\leq x<2.0$)であることを特徴とする請求項 $8\sim12$ いずれか1項記載の着色膜、着色帯電防止膜、着色低反射帯電防止膜。

【請求項14】請求項7~13いずれか1項記載の着色 膜、着色帯電防止膜、着色低反射帯電防止膜を形成した 陰極線管。

【請求項15】請求項7~13いずれか1項記載の着色膜、着色帯電防止膜、着色低反射帯電防止膜を形成したガラス物品。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は陰極線管用パネル等に適 用される着色膜形成用塗布液、着色膜、着色帯電防止膜 および着色低反射帯電防止膜に関する。

[0002]

【従来の技術】帯電防止膜、着色膜、着色帯電防止膜、低反射帯電防止膜、着色低反射帯電防止膜のコーティング方法は従来より光学機器においてはいうまでもなく、民生用機器特にTV、コンピューター端末の陰極線管(CRT)に関し多くの検討がなされてきた。

【0003】帯電防止に関しては、例えば特開昭63-76247号にはブラウン管パネル表面を350℃程度に加熱してCVD法により酸化スズおよび酸化インジウム等の導電性酸化物層を設ける方法が提案されている。【0004】膜の着色に関しては、特開平1-275664号に水溶性フタロシアニン化合物を用いる方法が提案されている。帯電防止性能をもつ着色膜については特開平1-251545号にメチルバイオレットを用いた帯電防止膜の記載がある。

mから700nmの波長領域において透過率が低下さ 【0005】低反射性に関しては例えば特開昭61-1 れ、かつ帯電防止能および低反射能を有する着色低反射 50 18931号記載の如くブラウン管表面に防眩効果をも

たせるため、表面に微細な凹凸を有するSiO2層を付着させたり、弗酸により表面をエッチングして凹凸を設ける等の方法が採られてきた。しかし、これらの方法は、外部光を散乱させるノングレア処理と呼ばれ、本質的に低反射層を設ける方法ではないため、反射率の低減には限界があり、またブラウン管等においては解像度を低下させる原因ともなっていた。

【0006】低反射帯電防止膜については、特開平3-93136号にイオンプレーティング法による光学多層膜を設ける方法が記載されている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】上述の方法のうち、C VD法による帯電防止膜を付与させる手法は、装置コストがかかることに加えてブラウン管表面を高温に加熱するためブラウン管内の蛍光体の脱落を生じたり、寸法精度が低下する等の問題があった。またこの場合通常400℃程度の高温を必要とし、低温で焼成した場合充分低抵抗な膜が得られない欠点があった。

【0008】また上記着色膜の水溶性フタロシアニン化合物を用いる方法は、有機染料を用いるため耐熱性、耐20候性に乏しく特定波長に吸収をもつため可視光全波長領域にわたって均一な吸収を得ることが難しいという欠点がある。特開平1-251545号記載のメチルバイオレットを含む帯電防止膜も同様な理由より耐熱性、耐候性に乏しく可視光全波長領域にわたって均一な吸収を得ることが難しい。

【0009】またイオンプレーティングによる方法は工 業的に安価とはいえず、また可視光波長領域にわたって の均一な吸収を得られないため陰極線管に成膜したとき コントラストの向上も望めない。また溶液の基体への塗 30 布方法は、スピンコート法、ディップコート法、ロール コーター法、メニスカスコーター法等、種々考えられる が、特にスピンコート法は量産性、再現性に優れ、好ま しく用いられる。かかる方法によって10 n m~1 μ m 程度の膜が形成可能である。しかし液中に粒子を分散し た溶液でスピンコート塗布をする際は塗膜時に生じる液 の流れ跡、粒子の流れた跡、膜乾燥時の粒子の凝集、乾 燥むら、膜厚差による色むら等の問題があり外観良好な 膜を成膜することは難しく、さらに塗布液の基体に対す る濡れ性の善し悪し、外気の変動による影響の受け易さ 40 は生産性を悪くする原因となるため、溶液中の溶媒の選 択および組成比が重要であった。

【0010】本発明は従来技術の前述の欠点を解決し、 低温熱処理により膜形成が可能な着色膜形成用塗布液、 着色膜、着色帯電防止膜および着色低反射帯電防止膜を 新規に提供することを目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明は、酸窒化チタン しい。このような観点より鋭意研究を行った結果、酸窒と、Sn有機酸塩および/またはCo有機酸塩とを含む 化チタンを含む着色膜を構成することにより、可視光領着色膜形成用塗布液、また、酸窒化チタンと、Si(O 50 域において均一な光吸収を可能とし上記の問題点を解決

4

R)。R'n(m+n=4、 $m=1\sim4$ 、 $n=0\sim3$ 、R、R'= $C_1\sim C_4$ のアルキル基)またはその加水分解物と、Sn有機酸塩と、 β -ジケトンとを含み、さらに、プロピレングリコールエーテル、その誘導体、プロピレングリコールエーテルアセテートおよびその誘導体からなる群から選ばれる少なくとも1種と、メタノール、エタノール、およびプロパノールからなる群から選ばれる少なくとも1種と、ジアセトンアルコールとを含むことを特徴とする前記の着色膜形成用塗布液、さらに、Sn、In、Sb、Zn、Al およびGaのうち少なくとも1種からなる導電性酸化物を含むことを特徴とする前記の着色膜形成用塗布液を提供する。

【0012】また本発明は、前記の塗布液を塗布した 後、加熱および/または紫外線を照射することにより得 られたことを特徴とする380 n mから700 n mの波 長領域において透過率が低下された着色膜を提供する。 さらに本発明は、基体表面に、酸窒化チタンを含み、さ らにSn有機酸塩およびCo有機酸塩のうち少なくとも 1種を含む溶液を塗布した後加熱および/または紫外線 を照射してなることを特徴とする着色膜、基体表面に、 酸窒化チタンを含み、さらにSn有機酸塩、さらにS n、In、Sb、Zn、A1、Gaのうち少なくとも1 種の酸化物を含む溶液を塗布した後加熱および/または 紫外線を照射してなることを特徴とする着色帯電防止 膜、当該着色帯電防止膜の上に低屈折率を有する膜を形 成することを特徴とする着色低反射帯電防止膜、および 基体上に多層膜からなり、そのうち少なくとも1層が上 記着色帯電防止膜であることを特徴とする着色低反射帯 電防止膜を提供する。

【0013】本発明はディスプレイ用途に供されるガラス物品の表面へのコーティングに対し最適である。かかるガラス物品としての陰極線管は近年コンピューターの端末表示等に使用される場合、高解像度の要求とともにハイコントラストの要求も高まりつつある。しかしコントラストの向上を期してガラス自体の透過率を低下させた場合、ディスプレイの大型化に伴ってフェイスプレートの肉厚も厚くなっていることから、特に大型ディスプレイでは透過率の著しい低下が問題となる。本発明ではガラス自体の透過率を下げることなくその表面に膜を形成しこの膜で光吸収を生じさせることによりコントラストの向上を図ることができる。

【0014】したがって、種々の肉厚をもつディスプレイ用ガラスパネルへの適用が極めて容易に可能となる。 陰極線管の発光スペクトルは複数のスペクトルで構成されるが、発光スペクトルのバランスを崩さずにコントラストの向上を図るには特定の光吸収を持つ着色膜よりも可視光領域にわたって均一の光吸収を持つ着色膜が好ましい。このような観点より鋭意研究を行った結果、酸窒化チタンを含む着色膜を構成することにより、可視光領域において均一な光吸収を可能とした記の問題点を解決 できた。

【0015】しかし一方で酸窒化チタンは比較的耐熱性に優れるが空気中等酸化雰囲気中で長時間高温焼成した場合、酸化退色することにより可視光域での均一な吸収が損なわれ、陰極線管上に成膜した際も所定のコントラスト向上効果が望めない場合がある。本発明では酸窒化チタンの対酸化性向上にSn有機酸塩やCo有機酸塩が効果を有することを見いだした。

【0016】また、ナフテン酸第一スズ、2-エチルへキサン酸スズ等の有機酸スズは加水分解し易く、水分を 10 含む溶媒と混合すると沈澱を生じるため、外観良好な膜を得るための溶媒が、および導電性酸化物と酸窒化チタン粒子の分散媒が限定されるため、また空気中の水分とも反応する可能性があり、塗布液の安定性という点で問題があった。本発明ではβージケトンにより有機酸スズを安定化することにより加水分解が抑制され、膜特性が向上し、さらに液の安定性も向上することが見いだされた。

【0017】また本発明においては塗布をする際に塗膜時に生じる液の流れ跡、粒子の流れた跡、膜乾燥時の粒 20子の凝集、乾燥むら、膜厚差等が少ない外観良好な膜を成膜するために塗布液中に水、C1~C4の低級アルコールの他にプロピレングリコールエーテル、その誘導体、プロピレングリコールエーテルアセテートおよびその誘導体からなる群から選ばれる少なくとも1種を0.1~70wt%と、ジアセトンアルコールを0.1~30wt%加えており、それによって基体に対する濡れ性がよく外気の影響を受けにくい塗布液が得られる。

【0018】さらに本発明ではこの着色膜にSn、In、Sb、Zn、AlおよびGaのうち少なくとも1種30の酸化物を含有することによりディスプレイのオン・オフ時に生起する静電気を抑える帯電防止性能も付与させ、ほこり等の付着を抑制することも可能とした。さらには上記着色帯電防止膜上に当該被膜よりも低屈折率を有する膜を構成し解像度を損なうことなく蛍光灯の映り込み等を抑制する低反射性能をも付与することも可能とした。

【0019】本発明で用いる酸窒化チタン粒子は還元処理した酸化チタンを用いる。還元処理にはN2ガス、NH3ガス等を用いることができる。酸窒化チタン自体導 40電性を有しているため、帯電防止膜を構成する場合導電補助成分として機能する。酸窒化チタンは、Nを0.1~30wt%含有するTiOx(1.0≦x<2.0)であることが好ましい。また、酸窒化チタンの溶液中での含有量は、着色膜の場合溶液中の全固型分量に対し1~90wt%が好ましく、これ以下の場合着色性能が充分でなく、これ以上の場合は膜の強度が低下し好ましくない。着色帯電防止膜、着色低反射帯電防止膜の場合は1~80wt%が好ましい。酸窒化チタン量が少なすぎると着色性能が充分でまた多すぎると帯電防止能およ 50

び膜の透過率が悪化し好ましくない。

【0020】また本発明で用いるSn有機酸塩やСo有機酸塩としては、酢酸塩、酒石酸塩、カルボン酸塩等種々の化合物が使用可能であるが、溶解性、酸窒化チタンに対する耐酸化性向上効果の点からそれぞれナフテン酸第1スズ、2ーエチルへキサン酸スズ、およびナフテン酸第1コバルト、2ーエチルへキサン酸コバルトを用いることが好ましい。Sn有機酸塩やСo有機酸塩の溶液中での含有量はそれぞれSn〇2、Сo3 〇4 換算で前固形分量に対し1~60wt%の範囲にあることが好ましい。これ以下であると酸窒化チタンの耐酸化性向上効果、および色調が劣り、これ以上であると膜強度の低下が起こるため好ましくない。

【0021】また本発明では液中にSi(OR)。R'。 (m+n=4、m=1~4、n=0~3、R、R'= C1~C4のアルキル基)、またはその加水分解物を加えることにより溶液中の粒子の安定性が向上し、アルコール類、ケトン類、エーテル類、エステル類、アルコールエステル類、ケトンエステル類、エーテルアルコール類、ケトンエーテル類、エステルエーテル類のうちの1種または2種以上の混合物からなる有機溶剤で希釈した場合でも凝集沈澱を生じることがない。その含有量については酸化物換算で全固形分に対して0.5~65wt%が好ましく、これ以下であると粒子を含む溶液に有機溶剤を混合させたときに沈澱を生じることがあり、これ以上であると着色性能および帯電防止性能が悪化してしまう。

【0022】また本発明で用いる β -ジケトンとしては種々のものが使用可能であり特に限定されないが、アセチルアセトンが特に好ましく用いられる。溶液中のの含有量はSn有機酸塩の $0.1\sim10$ 倍モルが好ましい。これ以下であると液の安定性に寄与せず、これ以上であると膜強度の低下が起こるため好ましくない。

【0023】本発明におけるプロピレングリコールエーテル、その誘導体、プロピレングリコールエーテルアセテートおよびその誘導体からなる群から選ばれる少なくとも1種は特に限定されるものではなく、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノプロピルズーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモのプロピルエーテルアセテート等いずれも使用可能である。

の含有量は、着色膜の場合溶液中の全固型分量に対し1 【 0024】本発明で用いる導電性酸化物には、Sbを ~90wt%が好ましく、これ以下の場合着色性能が充 ドープしたSnO2、ITO、AlをドープしたZn 分でなく、これ以上の場合は膜の強度が低下し好ましく ひ、GaをドープしたZnOを用いることができる。こ れらの酸化物は導電性を有しており、形成された膜に導 1~80wt%が好ましい。酸窒化チタン量が少なすぎ 電性を付与することができ、帯電防止性能を付与することを着色性能が充分で、また多すぎると帯電防止能およ 50 とができる。これらの酸化物は塗布液中に微粒子として

分散させて用いることも可能であり、また溶液として用いて基体上で酸化物化させることも可能である。

【0025】これらの粒子あるいは塩の分散媒、分散法も特に限定されるものではなく種々の溶媒および分散法が使用可能である。好ましくは、水あるいはアルコール等の有機溶媒中に粒子を添加し、酸あるいはアルカリを添加しpHを調整し、コロイドボールミル、サンドミル、ホモジナイザー、等の市販の粉砕器で分散させて得ることができる。この場合、分散中の粒子の平均粒径は300nm以下となっていることが好ましい。溶液を用10いる場合、キレート錯体のような有機化合物、硝酸塩のような無機化合物を用い上記の粒子を分散した液と混合して用いる。

【0026】また、溶液の基体への塗布方法は、スピンコート法、ディップ法、スプレー法、ロールコーター法、メニスカスコーター法等種々考えられるが、特にスピンコート法は量産性、再現性に優れ、好ましく採用可能である。かかる方法によって100Å~1μm程度の膜が形成可能である。

【0028】無反射条件を満たすには、(1)式において、R=0とおき、

【0029】 $n = (n_0 n_s)^{1/2} \cdots (2)$ 式が必要とされる。

【0030】(2)式を2層構成に拡張した場合、ns n₁²=n₂²n₀・・・(3)式となる(n₁:媒質側層、n₂:基体側層)。

【0031】ここでno=1(空気)、ns=1.52 (ガラス)を(3)式に適用した場合、n2/n1= 1.23となり、この場合、2層構成膜の最大の低反射 性が得られる。勿論n2/n1=1.23を満たさなく ても、2層膜の屈折率がこれに近い値をとれる場合、低 40 反射性が得られる。したがって、基体側に設ける高屈折 率層と媒質側に設ける低屈折率層は両者の屈折率比がで きるだけ1.23に近い値を選択するのが望ましい。

【0032】本発明において、所望の低反射膜を得るには、多層膜間の屈折率差とあわせて膜厚も重要な要素である。反射防止性能を有する多層の低反射膜の構成としては、反射防止をしたい波長を入として、基体側より高屈折率層ー低屈折率層を光学厚み入/2-λ/4で構成した低反射膜、基体側より中屈折率層-高屈折率層ー低屈折率層を光学厚み入/4-λ/2-λ/4で形成した

8

3層の低反射膜、基体側より低屈折率層-中屈折率層-高屈折率層-低屈折率層を光学厚み入/4-λ/4-λ /2-λ/4で形成した4層の低反射膜等が典型的な例 として知られている。

【0033】本発明の着色膜を高屈折率膜として用い、その上層に低屈折率膜を設ける場合は、MgF2 ゾルを含む溶液や、加熱によりSiO2 となるSiTルコキシド等のSi 化合物を含む溶液のうちから選ばれる少なくとも1種よりなる溶液を用いて形成する。屈折率の面からみると該材料のうちMgF2 が最も低く反射率低減のためにはMgF2 ゾルを含む溶液を用いることが好ましいが、膜の硬度や耐擦傷性の点ではSiO2 を主成分とする膜が好ましい。

【0034】低屈折率膜形成用のSi化合物を含む溶液としては、Si(OR)。R'n(m+n=4、m=1~4、n=0~3、R、R'=C1~C4のアルキル基)で示される化合物あるいは部分加水分解物を用いることが好ましく、例えば、シリコンエトキシド、シリコンメトキシド、シリコンイソプロボキシド、シリコンブトキシドのモノマーあるいは重合体が好ましく使用可能であるが、珪弗化水素酸、硼酸を含む水溶液に二酸化珪素粉末を飽和させてなる溶液より析出させてできるSi化合物も使用可能である。Si(OR)。R'nで示される化合物あるいは部分加水分解物の着色帯電防止膜上への塗布方法としては、前述した方法と同様に種々の方法が好ましく採用可能である。

【0035】本発明の着色帯電防止膜は酸窒化チタンを 含有するため、高屈折率を有し上記低屈折率膜との2層 で構成した場合前述の低反射性能が容易に発現される。

【0036】本発明において、着色膜、着色帯電防止膜、着色低反射帯電防止膜を形成する基体としは特に限定されるものではなく、目的に応じてソーダライムシリケートガラス、アルミノシリケートガラス、硼珪酸塩ガラス、リチウムアルミノシリケートガラス、石英ガラス等のガラス、鋼玉等の単結晶、マグネシア、サイアロン等の透光性セラミックス、ポリカーボネイト等のプラスチックも使用できる。また、その用途はブラウン管フェイスパネル用、複写機用、計算機用、クリーンルーム用、CRTやLCDなどの表示装置用、など各種用途に及ぶものである。

[0037]

【作用】本発明においてSn有機酸塩やCo有機酸塩による酸窒化チタンの耐酸化性向上効果のメカニズムについては明確ではないが、Sn、Coが2価で存在することにより酸化雰囲気中で高温焼成した際、Sn、Coや有機酸の還元効果により酸窒化チタンの耐酸化性が向上するものと思われる。

屈折率層-低屈折率層を光学厚み $\lambda/2-\lambda/4$ で構成 【0038】また β -ジケトンの効果も明確ではないがした低反射膜、基体側より中屈折率層-高屈折率層-低 Sn有機酸塩、Co有機酸塩に配位することにより液の屈折率層を光学厚み $\lambda/4-\lambda/2-\lambda/4$ で形成した 50 安定性が増すものと思われる。全可視光領域において均

30

一な吸収に起因して低反射特性も向上する。更には窒素 を含有してなる酸化チタン自体も導電性を有しているた め酸窒化チタンも帯電防止能を発現させる成分として機 能している。

[0039]

【実施例】以下に実施例により本発明を具体的に説明す るが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではな い。得られた膜の評価結果は下記のとおりである。

【0040】透過率評価:日立製作所製スペクトロフォ トメータU-3500により380nm、550nm、 780 nmの透過率を測定した。

【0041】ヘーズ評価:スガ試験機製直読ヘーズコン ピューターにより膜自体のヘーズを測定した。

【0042】導電性評価:着色帯電防止膜、低反射帯電 防止膜について三菱油化製ハイレスタ抵抗測定器により 相対湿度30%以下の雰囲気中で膜表面の表面抵抗値を 測定した。

【0043】耐擦傷性: 1 k g重の荷重下で (LION 製50-50)、消しゴムで膜表面を50回往復後、そ の表面の傷の付きを目視で判断した。評価基準は以下の 20 通りとした。○:傷が全く付かない、 \triangle :傷が多少付 く、×:多くの傷が付くか剥離。

【0044】鉛筆硬度:1kg重の荷重下、鉛筆で膜表 面を走査し、その後目視により表面の傷の生じ始める鉛 筆の硬度を膜の鉛筆硬度と判断した。

【0045】視感反射率:着色低反射帯電防止膜につい てGAMMA分光反射スペクトル測定器により膜の38 0~700 n mの視感反射率を測定した。

【0046】液中の粒子の分散安定性の評価:大塚電子 製レーザー粒径解析システムLAP-3100により液 30 合成直後および5℃で4週間静置保存したのち液中の粒 子の平均粒径を測定した。

【0047】[実施例1]酸窒化チタン粉末15gをあ らかじめp H 3. 0に調整した水溶液85g中に添加し てサンドミルで4時間粉砕して90℃で1時間加熱した のち、濃度10wt%に調整し、平均粒径90nmのゾ ルを得た(A液)。Si(OEt)4のエタノール溶液 (酸化物換算で固形分20wt%) にSi(OEt)4 に対してpH3.0に調整した塩酸酸性水溶液を8mo 1比添加し、80℃で2時間撹拌下で還流を行った(B 40 液)。2-エチルヘキサン酸スズを酸化物換算で固形分 3wt%になるようにエタノールで希釈した(C液)。 【0048】A液とB液、C液を各酸化物換算で1.2 wt%となるようにエタノールで希釈した後、A液:B 液:C液=65:20:15重量比となるように混合 し、ブラウン管パネル表面に100rpmの回転速度で 60秒間塗布し、その後160℃で30分間加熱し約1 〇〇nmの厚さの膜を得た。

【0049】[実施例2]実施例1におけるA液とC液

で希釈した後、A液:C液=65:35重量比となるよ うに混合した以外は実施例1と同様に行い、約100 n

10

mの厚さの膜を得た。

【0050】[実施例3] Sbが8mo1%ドープされ たSnO₂ 粉末(1次粒径100Å)15gを水85g 中に添加してサンドミルで16時間粉砕して90℃で1 時間加熱した後、濃度10wt%に調整し、平均粒径5 Onmのゾルを得た(D液)。

【0051】D液および実施例1におけるA液とB液と C液を各酸化物換算で1.2wt%となるようにエタノ 10 ールで希釈した後、A液:B液:C液:D液=45:2 0:15:20重量比となるように混合し、ブラウン管 パネル表面に100rpmの回転速度で60秒間塗布 し、その後160℃で30分間加熱し約90 nmの厚さ の膜を得た。

【0052】 [実施例4] 2-エチルヘキサン酸コバル トを酸化物換算で固形分3wt%になるようにエタノー ルで希釈した(E液)。

【0053】実施例1におけるA液、B液、C液および 実施例3におけるD液およびE液を各酸化物換算で1. 2wt%となるようにエタノールで希釈した後、A液: B液: C液: D液: E液=35:20:15:20:1 0重量比となるように混合し、ブラウン管パネル表面に 100rpmの回転速度で60秒間塗布し、その後16 0℃で30分間加熱し約90nmの厚さの膜を得た。

【0054】 [実施例5] Sbが8mo1%ドープされ たSnO2 粉末(1次粒径100Å)15gを水85g 中に添加してサンドミルで4時間粉砕して90℃で1時 間加熱した後、濃度10wt%に調整し、平均粒径50 nmのゾルを得た(D液)。

【0055】D液および実施例1におけるA液とB液と C液を各酸化物換算で1.2wt%となるようにエタノ ールで希釈した後、A液:B液:C液:D液=45:2 0:15:20重量比となるように混合し、ブラウン管 パネル表面に100rpmの回転速度で60秒間塗布 し、その後60℃で10分間加熱し約100 nmの厚さ の膜を得た。この膜上にSi(OEt)4のエタノール 溶液(酸化物換算で固形分20wt%)にSi(OE t)4 に対してpH3.0に調整した塩酸酸性水溶液を 8mo1比添加し、80℃で2時間撹拌を行った後、エ タノールで酸化物換算0.9wt%に希釈した溶液(E 液)を100rpmの回転速度で60秒間塗布し、その 後380℃で30分間加熱し2層構成の着色低反射帯電

【0056】 [実施例6] 2-エチルヘキサン酸コバル トを酸化物換算で固形分3wt%になるようにエタノー ルで希釈した(F液)。

【0057】F液および実施例1におけるA液、B液、 C液および実施例3におけるD液を各酸化物換算で1. を各酸化物換算で1.2wt%となるようにエタノール 50 2wt%となるようにエタノールで希釈した後、A液:

B液: C液: D液: F液=35: 20: 15: 20: 1 0重量比となるように混合し、ブラウン管パネル表面に 100 r p mの回転速度で60秒間塗布し、その後60 ℃で30分間加熱し約100nmの厚さの膜を得た。こ の膜上にSi (OEt)4 のエタノール溶液(酸化物換 算で固形分20wt%) にSi (OEt)4 に対してp H3. 0に調整した塩酸酸性水溶液を8mo1比添加 し、80℃で2時間撹拌を行った後、エタノールで酸化 物換算0.9wt%に希釈した溶液(E液)を100r pmの回転速度で60秒間塗布し、その後380℃で3 10 0分間加熱し2層構成の着色低反射帯電防止膜を得た。 【0058】[実施例7] I TO粉末 (Sn/I n (m ol比)=10/90、1次粒径300Å)15gを水 85g中に添加してサンドミルで4時間粉砕して90℃ で1時間加熱した後、濃度10wt%に調整し、平均粒 径90 n m のゾルを得た(G液)。

【0059】G液および実施例1におけるA液とB液とC液を各酸化物換算で1.2wt%となるようにエタノールで希釈した後、G液:A液:B液:C液=20:45:20:15重量比となるように混合し、ブラウン管20パネル表面に100rpmの回転速度で60秒間塗布し、その後60℃で30分間加熱し約100nmの厚さの膜を得た。この膜上にSi(OEt)4のエタノール溶液(酸化物換算で固形分20wt%)にSi(OEt)4に対してpH3.0に調整した塩酸酸性水溶液を8mol比添加し、80℃で2時間撹拌を行った後、エタノールで酸化物換算0.9wt%に希釈した溶液(E液)を100rpmの回転速度で60秒間塗布し、その後380℃で30分間加熱し2層構成の着色低反射帯電防止膜を得た。30

【0060】[実施例8]酸窒化チタン14gおよびSbが8mo1%ドープされたSnO2粉末(1次粒径100Å)6.0gをあらかじめpH13に調整した水80g中に添加してサンドミルで16時間粉砕して90℃で1時間加熱した後、濃度10wt%に調整し、平均粒径90nmのゾルを得た(H液)。

【0061】H液および実施例1におけるA液とB液とC液を各酸化物換算で1.2wt%となるようにエタノールで希釈した後、A液:B液:C液:H液=45:20:15:20重量比となるように混合し、ブラウン管40パネル表面に100rpmの回転速度で60秒間塗布し、その後60℃で30分間加熱し約100nmの厚さの膜を得た。この膜上にSi(OEt)4のエタノール溶液(酸化物換算で固形分20wt%)にSi(OEt)4に対してpH3.0に調整した塩酸酸性水溶液を8mo1比添加し、80℃で2時間撹拌を行った後、エタノールで酸化物換算0.9wt%に希釈した溶液(E液)を100rpmの回転速度で60秒間塗布し、その後380℃で30分間加熱し2層構成の着色低反射帯電防止膜を得た。50

12

【0062】 [実施例9] 実施例1におけるA液およびC液を各酸化物換算で1.2wt%となるようにエタノールで希釈した後、A液:C液=80:20重量比となるように混合し、ブラウン管パネル表面に100rpmの回転速度で60秒間塗布し、その後160℃で30分間加熱し約100nmの厚さの膜を得た。

【0063】[実施例10]実施例1におけるA液、B液、C液および実施例3におけるD液を各酸化物換算で1.2wt%となるようにエタノールで希釈した後、A液:B液:C液:D液=40:18:2:40重量比となるように混合し、ブラウン管パネル表面に100rpmの回転速度で60秒間塗布し、その後160℃で30分間加熱し約100nmの厚さの膜を得た。

【0064】 [実施例11] ナフテン酸コバルトを酸化物換算で3wt%になるようにエタノールで希釈した(H液)。

【0065】実施例1におけるA液、B液、実施例3におけるD液およびH液をA液:B液:D液:H液=45:20:20:15重量比となるように混合し、ブラウン管パネル表面に100rpmの回転速度で60秒間塗布し、その後60℃で30分間加熱し約100nmの厚さの膜を得た。この膜上に実施例7におけるE液を100rpmの回転速度で60秒間塗布し、その後380℃で30分間加熱し2層構成の着色低反射帯電防止膜を得た。

【0066】 [比較例1] 実施例1におけるA液とB液を各酸化物換算で1.2wt%となるようにエタノールで希釈した後、A液:B液=80:20重量比となるように混合し、ブラウン管パネル表面に100rpmの回転速度で60秒間塗布し、その後160℃で30分間加熱し約100nmの厚さの膜を得た。

【0067】 [比較例2] 実施例1におけるA液とB液および実施例3におけるD液を各酸化物換算で1.2w t%となるようにエタノールで希釈した後、A液:B液:D液=40:20:40重量比となるように混合し、ブラウン管パネル表面に100rpmの回転速度で60秒間塗布し、その後60℃で30分間加熱し約100nmの厚さの膜を得た。

【0068】[比較例3]実施例1におけるA液、B 40 液、C液および実施例3におけるD液を各酸化物換算で 1.2wt%となるようにエタノールで希釈した後、A 液:B液:C液:D液=40:19.5:0.5:40 重量比となるように混合し、ブラウン管パネル表面に1 00rpmの回転速度で60秒間塗布し、その後160 ℃で30分間加熱し約100nmの厚さの膜を得た。こ の膜上にSi(OEt)4のエタノール溶液(酸化物換 算で固形分20wt%)にSi(OEt)4に対してp H3.0に調整した塩酸酸性水溶液を8mo1比添加 し、80℃で2時間撹拌を行った後、エタノール酸化物 類質0.9wt%に希釈した溶液(E液)を100rp

mの回転速度で60秒間塗布し、その後380℃で30分間加熱し2層構成の着色低反射帯電防止膜を得た。

*【0070】 【表1】

【0069】以上の結果を表1に示す。

	透過 ² 380nm	学の低下 550mm	% 780nm	ヘーズ %	表面抵抗	耐擦 傷性	鉛筆 硬度	視感反 射率%
実施例1	25 28	21 21	24 24	0.1 0.1	4×10 ¹⁰ 9×10 ⁹	0	7 H 7 H	-
実施例3	22	18	21	0.1	3×10°	Ö	7 H	-
実施例4	20 24	18 20	20 23	0.1 0.1	4×10° 3×10°	0	6 H 6 H	- 0.5
実施例6	22	20	23 22	0.1	3×10°	0	6 H	0.8
実施例7	25	20	23	0.1	2×10°	0	7 H	-
実施例8	23 25	20 30	23 27	0.1 0.1	2×10° 1×10¹°	0	6 H 9 H	<u>-</u>
実施例10	18	16	14	0.1	1×10°	0	7 H	-
実施例11 比較例1	22 12	20 8	23 6	0. 1 0. 2	3×10 ⁸ 6×10 ¹⁰	0	7 H 7 H	0.6
比較例2	7	3	2	0.2	2×10 ⁹	0	7 H	-
比較例3	6	3	2	0.2	1×10°	0	6 H	0.7

【0071】[実施例12]酸窒化チタン15gをあら % かじめpH3.0に調整した水溶液85g中に添加してサンドミルで4時間粉砕して90℃、1時間加熱したのち、濃度5wt%に調整し、平均粒径90nmのゾルを得た(I液)。Si(OEt)4のエタノール溶液(酸化物換算で固形分5wt%)にSi(OEt)4に対してpH3.0に調整した硝酸酸性水溶液を8mol比添加し、80℃で2時間還流した(J液)。エタノール1 300g中にアセチルアセトン7.5gを添加し、2-エチルヘキサン酸スズ16gを加え、1時間撹拌した(K液)。

【0072】 I 液と J 液と K 液を I 液: J 液: K 液 = 6:3:1 重量比となるように混合した。 この混合液 1 2. 6 gにエタノール 8. 4 g、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート 2 7. 3 g、イソプロピルアルコール 7. 8 g、ジアセトンアルコール 3. 9 g を混合し、着色膜用コート液とした。

【0073】 [実施例13] Sbが8mo1%ドープさ 40 れたSnO2 微粒子(1次粒径10nm) 15gをKO HであらかじめpH8. 0とした水85g中に添加して サンドミルで16時間粉砕して90℃で1時間加熱した 後、濃度5wt%に調整しゾルを得た(L液)。

【0074】 I液と J液と K液と L液を I液: J液: K液: L液=15:30:10:45 重量比となるように混合した。この混合液12.6gにエタノール8.4 ※

※g、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート27.3g、イソプロピルアルコール7.8g、ジアセトンアルコール3.9gを混合し、着色帯電防止膜用コート液とした。

【0075】[実施例14]実施例13におけるSbが8mol%ドープされたSnO2 微粒子のかわりにITO微粒子(Sn/In=10/90mol比、1次粒径30nm)を用いた以外は実施例13と同様に行った。【0076】[実施例15]実施例13におけるSbが8mol%ドープされたSnO2 微粒子のかわりにAlが10mol%ドープされたZnO微粒子(1次粒径20nm)を用いた以外は実施例13と同様に行った。

【0077】 [実施例16] 実施例13におけるSbが 8mo1%ドープされたSnO2 微粒子のかわりにGa が8mo1%ドープされたZnO微粒子(1次粒径40 nm)を用いた以外は実施例13と同様に行った。

【0078】 [比較例4] エタノール100g中に、2 ーエチルヘキサン酸スズ15gを加え、1時間撹拌した (M液)。実施例13におけるK液のかわりにM液を用 いた以外は実施例13と同様に行った。

【0079】実施例12~16および比較例4において作製された塗布液の評価結果を表2に示す。

[0080]

【表2】

6/26/2006, EAST Version: 2.0.3.0

14

合成直後の平均粒径	4週間後の平均粒径
90nm	90 nm
9 2 nm	9 2 nm
97 n m	98 nm
97 nm	9 9 n m
100nm	103nm
96 nm	240 nm
	90nm 92nm 97nm 97nm 100nm

【0081】 [実施例17] 実施例12において得られ たコート液をブラウン管パネル表面に100rpmの回 転速度で60秒間塗布し、その後380℃で30分加熱 し約90 nmの厚さの膜を得た。

【0082】[実施例18] 実施例13において得られ たコート液をブラウン管パネル表面に100rpmの回 転速度で60秒間塗布し、その後380℃で30分加熱 し約90nmの厚さの膜を得た。

【0083】 [実施例19] 実施例14において得られ たコート液をブラウン管パネル表面に100rpmの回 20 転速度で60秒間塗布し、その後380℃で30分加熱 し約90 nmの厚さの膜を得た。

【0084】[実施例20]実施例15において得られ たコート液をブラウン管パネル表面に100rpmの回 転速度で60秒間塗布し、その後380℃で30分加熱 し約90 nmの厚さの膜を得た。

【0085】[実施例21]実施例16において得られ たコート液をブラウン管パネル表面に100 rpmの回 転速度で60秒間塗布し、その後380℃で30分加熱 し約90 nmの厚さの膜を得た。

【0086】[実施例22]酸窒化チタン15gおよび Sbが8mol%ドープされたSnO2 粒子(1次粒径 10nm) 5.0gをあらかじめpH13に調整した水 80g中に添加してサンドミルで16時間粉砕して90 ℃で1時間加熱した後、濃度10wt%に調整し、平均 粒径90nmのゾルを得た(N液)。N液および実施例 12におけるJ液とK液をJ:K:N=3:1:6重量 比となるように混合した(P液)。P液12.6gにエ タノール8.4g、プロピレングリコールモノメチルエ ーテルアセテート27.3g、イソプロピルアルコール 40 7.8g、ジアセトンアルコール3.9gを混合し、着 色帯電防止膜用コート液とした。ブラウン管パネル表面 に100rpmの回転速度で60秒間塗布し、その後3 80℃で30分加熱し約90 n mの厚さの膜を得た。

【0087】[実施例23]実施例22におけるP液1 2.6gにエタノール8.4gプロピレングリコールモ ノメチルエーテルアセテート19.5g、イソプロピル アルコール15.6g、ジアセトンアルコール3.9g を混合し、着色帯電防止膜用コート液とした。ブラウン * し、その後380℃で30分加熱し約90nmの厚さの 膜を得た。

【0088】[実施例24]実施例22におけるP液1 2.6gにエタノール8.4gプロピレングリコールモ ノメチルエーテルアセテート35.1g、ジアセトンア ルコール3.9gを混合し、着色帯電防止膜用コート液 とした。ブラウン管パネル表面に100mpmの回転速 度で60秒間塗布し、その後380℃で30分加熱し約 90 nmの厚さの膜を得た。

【0089】[実施例25]実施例22におけるP液1 2.6gにエタノール8.4gプロピレングリコールモ ノプロピルエーテル27.3g、イソプロピルアルコー ル7.8g、ジアセトンアルコール3.9gを混合し、 着色帯電防止膜用コート液とした。ブラウン管パネル表 面に100 r p mの回転速度で60秒間塗布し、その後 380℃で30分加熱し約100 nmの厚さの膜を得 た。

【0090】[実施例26] J液20gにプロピレング リコールモノメチルエーテルアセテート52.5g、イ 30 ソプロピルアルコール42.0g、ジアセトンアルコー ル10.5gを混合した(Q液)。実施例22における 380℃、30分の加熱処理を60℃、10分の加熱処 理に変更し、約100nmの厚さの膜を得た。この膜の 上に、H液を実施例17記載のスピンコート法で塗布 し、380℃で30分加熱処理し着色低反射帯電防止膜 を得た。

【0091】[実施例27]実施例23における380 ℃、30分の加熱処理を60℃、10分の加熱処理に変 更し、約100 n mの厚さの膜を得た。この膜の上に、 H液を実施例17記載のスピンコート法で塗布し、38 0℃で30分加熱処理し着色低反射帯電防止膜を得た。 【0092】 [比較例5] 比較例4において得られたコ ート液をブラウン管パネル表面に100rpmの回転速 度で60秒間塗布し、その後380℃で30分加熱し約 90 n mの厚さの膜を得た。

【0093】[比較例6]P液12.6gにエタノール 8.4g、メチルエチルケトン27.3g、イソプロピ ルアルコール7.8g、ジアセトンアルコール3.9g を混合し、着色帯電防止膜用コート液とした。ブラウン 管パネル表面に100rpmの回転速度で60秒間塗布×50 管パネル表面に100rpmの回転速度で60秒間塗布

17

し、その後380℃で30分加熱し約100nmの厚さ 【表4】 の膜を得た。

【0094】[比較例7] P液12.6gにエタノール8.4g、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート7.8g、イソプロピルアルコール23.4g、ジアセトンアルコール7.8gを混合し、着色帯電防止膜用コート液とした。ブラウン管パネル表面に100rpmの回転速度で60秒間塗布し、その後380℃で30分加熱し約100nmの厚さの膜を得た。

【0095】実施例17~27および比較例5~7にお 10 いて着色膜、着色帯電防止膜、着色低反射帯電防止膜の外観についての評価結果および膜特性の評価結果をそれぞれ表3、表4に示す。

[0096]

【表3】

	強膜の外観	
実施例17	良好	
実施例18	良好	20
実施例19	良好	
実施例20	良好	
実施例21	良好	
実施例22	良好	
実施例23	良好	
実施例24	良好	
実施例25	良好	
実施例26	良好	
実施例27	良好	
比較例5	凝集欠点多数発生、放射状すじ発生	30
比較例 6	放射状すじ発生、乾燥むら発生	50
比較例7	放射状すじ発生	

[0097]

6/26/2006, EAST Version: 2.0.3.0

		■の低门 550nm	₹ % 780mm	ヘーズ	表面抵抗	耐擦傷性	鉛筆硬度	視感反射率%
実施例17	23	19	2 1	0.1	7.0 ×10 ⁸	0	7 H	-
実施例18	22	17	20	0.1	8. 1 ×10 ⁸	0	7 H	-
実施例19	20	16	18	0.1	9. 1 ×10 ⁸	0	8 H	-
実施例20	19	15	18	0.1	4. 2×10 ⁸	0	8 H	-
実施例21	23	19	23	0.1	5. 1 ×10 ⁸	0	7 H	_
実施例22	23	19	2 1	0.1	1.0 ×10 ⁹	0	7 H	_
実施例23	2 1	18	20	0.1	2.0 ×10 ^a	0	7 H	-
実施例24	21	17	20	0.1	8. 2×10 ⁹	0	7 H	_
実施例25	18	16	1 7	0.1	5.0 ×10 ⁸	0	7 H	-
実施例26	16	1 3	1 5	0.1	2.5 ×10 ⁹	0	4 H	1. 25
実施例27	17	1 3	1 5	0.1	1.6 ×10 ⁹	0	4 H	1.07
比較例5	19	1 5	18	1.6	9.7 ×10°	Δ	7 H	_
比較例6	2 2	18	2 1	1.2	3. 2×10°	Δ	7 H	_
比較例7	18	1 5	1 7	1.0	1.8 ×10 ⁹	0	7 H	-

[0098]

【発明の効果】本発明の着色膜、着色帯電防止膜、着色 低反射帯電防止膜は、低温熱処理が可能であり、全可視 光領域において均一な吸収を有するため低反射特性がす ぐれている。また、窒素を含有してなる酸化チタン自体 は導電性を有しているため帯電防止能を発現することが できる。

【0099】本発明の塗布液は長期安定性に優れ、かつ スピンコート法で塗布する際に液の流れ跡、粒子の流れ*

20*た跡、膜乾燥時の粒子の凝集、乾燥むら、膜厚差等の少 ない、全可視光領域において均一な吸収を有する優れた 着色膜、着色帯電防止膜、着色低反射帯電防止膜を提供 することが可能となる。本発明は生産性に優れ、かつ真 空を必要としないので装置も比較的安価なものでよい。 特にCRTのパネルフェイス面等の大面積の基体にも充 分適用でき、量産も可能であるため工業的価値は非常に 高い。

フロントページの続き

(51) lnt. Cl. 6

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

CO9D 5/00

PPQ

183/04

PMS

HO1J 29/89 // G02B 1/10

(72)発明者 大橋 恵子

神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地 旭硝子株式会社中央研究所内

(72) 発明者 河里 健

神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地 旭硝子株式会社中央研究所内